

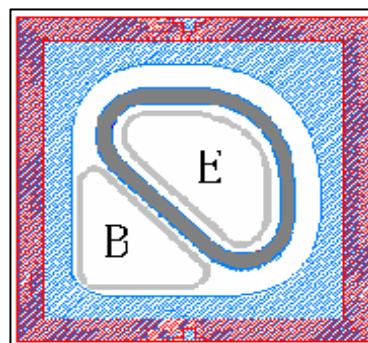


BC848 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸 (100mm)
 芯片代码：C035BJ-01
 芯片厚度：240±20μm
 管芯尺寸：350×350μm²
 焊位尺寸：B 极 12150μm²，E 极 16180μm²
 电极金属：铝
 背面金属：金
 典型封装：BC848

管芯示意图



极限值 (T_a=25) (封装形式：SOT-23)

T_{stg}——贮存温度.....-55~150
 T_j——结温.....150
 P_C——集电极耗散功率.....250mW
 V_{CB0}——集电极—基极电压.....30V
 V_{CEO}——集电极—发射极电压.....30V
 V_{EBO}——发射极—基极电压.....5V
 I_C——集电极电流.....100mA

电参数 (T_a=25) (封装形式：SOT-23)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
I _{CB0}	集电极—基极截止电流			0.1	μA	V _{CB} =30V, I _E =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			0.1	μA	V _{EB} =5V, I _C =0
h _{FE}	直流电流增益	100		1000		V _{CE} =5V, I _C =2mA
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压			0.5	V	I _C =100mA, I _B =5mA
V _{BE(sat)}	基极—发射极饱和电压			1.0	V	I _C =100mA, I _B =5mA
BV _{CB0}	集电极—基极击穿电压	30			V	I _C =100μA, I _E =0
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	30			V	I _C =1mA, I _B =0
BV _{EBO}	发射极—基极击穿电压	5			V	I _E =100μA, I _C =0
f _T	特征频率	100			MHz	V _{CE} =5V, I _C =10mA